【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成30年4月12日(2018.4.12)

【公開番号】特開2015-181156(P2015-181156A)
【公開日】平成27年10月15日(2015.10.15)
【年通号数】公開・登録公報2015-064
【出願番号】特願2015-39775(P2015-39775)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/8234　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　27/088　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　29/786　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　27/08　(2006.01)
Ｈ０３Ｋ　19/096　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　27/08　１０２Ｅ
Ｈ０１Ｌ　29/78　６１３Ｚ
Ｈ０１Ｌ　27/08　３３１Ｅ
Ｈ０１Ｌ　29/78　６１８Ｂ
Ｈ０１Ｌ　27/08　１０２Ｈ
Ｈ０３Ｋ　19/096　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成30年2月23日(2018.2.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の回路と、第２の回路と、第３の回路と、を有し、
前記第１の回路は、第１の端子と、第２の端子と、第３の端子とを有し、
前記第１の回路は、前記第３の端子に入力される信号に応じて、前記第１の端子と前記第２の端子との導通状態又は非導通状態を選択し、
前記第１の端子は、第１の配線と電気的に接続され、
前記第１の配線は、第１の電位を供給し、
前記第２の回路は、第４の端子と、第５の端子と、第６の端子とを有し、
前記第２の回路は、前記第６の端子に入力されるデータ信号に応じて、前記第４の端子と前記第５の端子との導通状態又は非導通状態を選択し、
前記第４の端子は、前記第２の端子と電気的に接続され、
前記第３の回路は、第７の端子と、第８の端子と、第９の端子とを有し、
前記第３の回路は、前記第９の端子に入力される信号に応じて、前記第７の端子と前記第８の端子との導通状態又は非導通状態を選択し、
前記第７の端子は、前記第５の端子と電気的に接続され、
前記第８の端子は、第２の配線と電気的に接続され、
前記第２の配線は、第２の電位を供給し、
前記第１の端子と前記第２の端子とが導通状態であるとき、前記第７の端子と前記第８の端子とは非導通状態であり、
前記第１の端子と前記第２の端子とが非導通状態であるとき、前記第７の端子と前記第

８の端子とは導通状態であり、
前記第１の回路は、第１のチャネルがシリコンに形成される第１のトランジスタを有し、
前記第２の回路は、第２のチャネルがシリコンに形成される第２のトランジスタを有し、
前記第３の回路は、第３のチャネルが酸化物半導体に形成される第３のトランジスタを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
請求項１において、
前記第３のトランジスタは、前記第１のトランジスタ又は前記第２のトランジスタの上方に設けられたことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
第１の回路と、第２の回路と、第３の回路と、を有し、
前記第１の回路は、第１の端子と、第２の端子と、第３の端子とを有し、
前記第１の回路は、前記第３の端子に入力される信号に応じて、前記第１の端子と前記第２の端子との導通状態又は非導通状態を選択し、
前記第１の端子は、第１の配線と電気的に接続され、
前記第１の配線は、第１の電位を供給し、
前記第２の回路は、第４の端子と、第５の端子と、第６の端子とを有し、
前記第２の回路は、前記第６の端子に入力されるデータ信号に応じて、前記第４の端子と前記第５の端子との導通状態又は非導通状態を選択し、
前記第４の端子は、前記第２の端子と電気的に接続され、
前記第３の回路は、第７の端子と、第８の端子と、第９の端子とを有し、
前記第３の回路は、前記第９の端子に入力される信号に応じて、前記第７の端子と前記第８の端子との導通状態又は非導通状態を選択し、
前記第７の端子は、前記第５の端子と電気的に接続され、
前記第８の端子は、第２の配線と電気的に接続され、
前記第２の配線は、第２の電位を供給し、
前記第１の端子と前記第２の端子とが導通状態であるとき、前記第７の端子と前記第８の端子とは非導通状態であり、
前記第１の端子と前記第２の端子とが非導通状態であるとき、前記第７の端子と前記第８の端子とは導通状態であり、
前記第１の回路は、第１のチャネルがシリコンに形成される第１のトランジスタを有し、
前記第２の回路は、第２のチャネルが酸化物半導体に形成される第２のトランジスタを有し、
前記第３の回路は、第３のチャネルがシリコンに形成される第３のトランジスタを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
請求項３において、
前記第２のトランジスタは、前記第１のトランジスタ又は前記第３のトランジスタの上方に設けられたことを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
第１の回路と、第２の回路と、第３の回路と、を有し、
前記第１の回路は、第１の端子と、第２の端子と、第３の端子とを有し、
前記第１の回路は、前記第３の端子に入力される信号に応じて、前記第１の端子と前記第２の端子との導通状態又は非導通状態を選択し、
前記第１の端子は、第１の配線と電気的に接続され、
前記第１の配線は、第１の電位を供給し、
前記第２の回路は、第４の端子と、第５の端子と、第６の端子とを有し、

前記第２の回路は、前記第６の端子に入力されるデータ信号に応じて、前記第４の端子と前記第５の端子との導通状態又は非導通状態を選択し、
前記第４の端子は、前記第２の端子と電気的に接続され、
前記第３の回路は、第７の端子と、第８の端子と、第９の端子とを有し、
前記第３の回路は、前記第９の端子に入力される信号に応じて、前記第７の端子と前記第８の端子との導通状態又は非導通状態を選択し、
前記第７の端子は、前記第５の端子と電気的に接続され、
前記第８の端子は、第２の配線と電気的に接続され、
前記第２の配線は、第２の電位を供給し、
前記第１の端子と前記第２の端子とが導通状態であるとき、前記第７の端子と前記第８の端子とは非導通状態であり、
前記第１の端子と前記第２の端子とが非導通状態であるとき、前記第７の端子と前記第８の端子とは導通状態であり、
前記第１の回路は、第１のチャネルがシリコンに形成される第１のトランジスタを有し、
前記第２の回路は、第２のチャネルが酸化物半導体に形成される第２のトランジスタを有し、
前記第３の回路は、第３のチャネルが酸化物半導体に形成される第３のトランジスタを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
請求項５において、
前記第２のトランジスタ又は前記第３のトランジスタは、前記第１のトランジスタの上方に設けられたことを特徴とする半導体装置。